



## 【1000～2000万円】Power Device Design Senior Engineer

外資系デバイスメーカーでの募集です。電子デバイス研究開発のご経験のある方は歓迎...

### 募集職種

#### 人材紹介会社

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

#### 採用企業名

外資系デバイスメーカー

#### 求人ID

1586991

#### 業種

通信・キャリア

#### 会社の種類

外資系企業

#### 雇用形態

正社員

#### 勤務地

大阪府

#### 給与

1000万円～2000万円

#### 勤務時間

09:00～18:00

#### 休日・休暇

詳細は求人ご紹介時にご案内いたします。

#### 更新日

2026年05月16日 07:00

### 応募必要条件

#### キャリアレベル

中途経験者レベル

#### 英語レベル

ビジネス会話レベル

#### 日本語レベル

ネイティブ

#### 最終学歴

大学卒：学士号

#### 現在のビザ

日本での就労許可が必要です

### 募集要項

#### 【求人No NJB2224778】

・高性能パワーデバイス（SiC MOSFET/SBD、GaN HEMT、Si IGBT）のデザイン開発とテスト検証を担当し、プロセスチームと協力してデバイス加工とプロセスの最適化を行う。  
・高性能パワーデバイス（SiC MOSFET/SBD、GaN HEMT、Si IGBT）の個別技術をフォローアップし、既存のデバイスの性能を向上させ、パテントポートフォリオを提案して実現させる。

## スキル・資格

### 必須要件

- ・半導体/電子/物理などの関連分野を専攻し、5年以上のパワーデバイスのデザイン開発経験（直近の3年間には関連のデザイン開発の従事必須）、または優秀な博士課程の新卒者。
  - ・パワーデバイス（SiC MOSFET/SBD、GaN HEMT、Si IGBT）の基本構造とデバイスシミュレーションデザイン方法に精通し、TCADソフトやレイアウトソフトを使用しデバイスデザインが得意な方。
  - ・良好なコミュニケーション能力があり、異なる地域や異なる文化背景のチームと良好なコミュニケーションがとれる方。
- 

## 会社説明

ご紹介時にご案内いたします